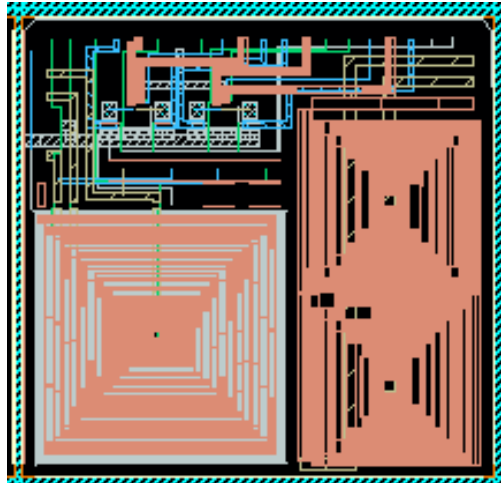




Ansteuer-IC für einen galvanisch getrennten High-Side-Gatetreiber



VERANTWORTLICHE FÜR DEN ENTWURF	Achim Seidel, Stephan Storm, Bernhard Wicht, Hochschule Reutlingen, Alteburgstraße 150, 72762 Reutlingen.
ENTWURFSVERFAHREN	Full Custom Design.
TECHNOLOGIE	180 nm Hoch-Volt BiCMOS.
CHIPFLÄCHE	4,9 mm x 4,76 mm.
GEHÄUSE	LCC 44.
FUNKTIONSBLÖCKE	2 LC-Oszillatoren, verschiedene Ausführungen integrierter Spulen und Übertrager
FUNKTION	Der Chip enthält zwei Varianten eines LC-Oszillators mit einem frequenzmodulierbaren Resonanzkreis zur Ansteuerung eines galvanisch getrennten Gatetreibers mit frequenzmoduliertem Ansteuersignal (100-200 MHz)
HERSTELLDATUM	III. Quartal 2014.
KOSTENTRÄGER	Industriepartner.